# FT-IR-ATR 法による表面分析

# 1. はじめに

箵

ATR 法では 2 つの物質の界面で光の全反射に伴って 起こる現象が利用されるが、吸収スペクトルの新しい測 定法として1960年代の当初に Harrick<sup>1)</sup>及び Fahrenfort<sup>2)</sup> らによって独立に開発された. ATR 法の特徴は Harrick の著書に詳細に解説されている<sup>3)</sup>. ATR 法では厚さ 0.1から数ミクロンの表面層を下地層から分離して測定 することができる. この特長のために開発後間もないこ ろから表面測定などに利用されてきた. しかしながら, 従来の分散型分光計,特に普及型分光計では測定精度が 充分でなく,良質の ATR スペクトルの測定が容易でな かったために,ATR 法の持つ表面測定法としての能力 が充分に発揮されるには至っていなかった.

1970年代の後半に FT-IR 分光計が市販されるように なったが、この分光計は測光精度及び波数精度に優れて いる上に、スペクトル処理機能を備えている.このた め、測定精度の高い ATR スペクトルに差スペクトル法 を応用することにより、FT-IR-ATR 法のさらに高度な 表面分析への応用が可能になった.それと同時に、最近 の表面処理技術の発達によって材料の表面分析の必要性 が高まったために、FT-IR-ATR 法が見直されることに なった.

筆者らは ATR 法と同じく光の全反射を利用した全反 射ラマン法を開発し、これを高度な表面分析に利用でき ることを明らかにした<sup>4)</sup>. その後、全反射ラマン法での 経験をもとに FT-IR-ATR 法のより高度な表面分析へ の応用について研究してきた. その結果、全反射の際の 光の挙動について充分考察したうえで、差スペクトル法 を利用すれば FT-IR-ATR 法が精密な表面分析に応用 できることが明らかになってきた. ここでは、ATR 法 が見直される元となった FT-IR 分光計についてその特 徴を概説し、ATR 法の表面測定法としての能力とその 高分子表面分析への若干の応用例について述べる.

### 2. FT-IR 分光計

一岩

本

吉\*

FT-IR 分光法及びその高分子への応用研究について は単行本<sup>51</sup>及び綜説<sup>61</sup>が出されている.ここでは分散型 分光計と FT-IR 分光計の使用上の特徴をユーザーの立 場で比較するにとどめる.

分散型赤外分光計では回折格子,フィルター及びスリ ットを用いて分光する.これに対して FT-IR 分光計で は光の分散現象を利用してハード的に分光することはせ ず,波長に対する強度分布に関する情報をマイケルソン 干渉計などにより「干渉光」としていったん記録する. 次に,この「干渉光」をフーリエ変換することによって 「ソフト的」に「分光」して,赤外光強度の波長分布す なわちスペクトルを得る.これは基本的にはシングルビ ームスペクトルであるため,プランクに対する比を取る ことによって試料の吸収スペクトルを得る.

- FT-IR 分光計は分散型分光計に比較して,
- (1) 全波数域を同時に、しかも短時間(分解能4 cm<sup>-1</sup>, 1回スキャンで約0.5秒)で測定できる.また、必要 に応じて積算し、S/N 比を改善できる.
- (2) スリットを使用せず,試料の吸収についての情報 を含む光を分析に有効に利用できる.
- (3) 分光計内に He-Ne レーザを内蔵しており、波長の基準を持つため、波数精度の高い(0.01 cm<sup>-1</sup>)測



\*大阪工業技術試験所(〒 563 大阪府池田市緑ケ丘 1-8-31) 第2部高分子物性 研究室長. 昭和36年高知大 学文理学部卒業,40年大阪 大学院博士課程中退. 40年 大阪大学理学部助手, 42年 大阪工業技術試驗所研究員. X線回析、ラマン分光及び 赤外分光による構造及び物 性の研究に従事、57年より 現職.

第58巻 第10号(1985)

吉

心定ができる

(4) 差スペクトルなど分析に有効なスペクトル処理機 能を持っている

などの特長がある. 「「「「」」」

実際上は FT-IR 分光計と分散型分光計の間でユーザ -の立場でどれ程の性能的な違いがあるだろうか. この 点を明らかにするため、対応する条件下で両分光計を比 較した例を述べよう<sup>7)</sup>. 用いた機種は Perkin Elmer 325 型分散型赤外分光計及びDigilab FTS-14型(検出器 TGS) FT-IR 分光計である. 性能比較に当たっては(1) 測定時間,(2)分解能及び(3)波数域を対応させ,分散型分 光計に対する FT-IR 分光計の S/N 比の相対比すなわち RFM(Relative Figure of Merit)で表した. 500~4,000 cm-1波数域での RFM は図1のようになる.分解能の 向上と共に RFM は増大する。一般に液体及び固体では 分解能4又は2 cm<sup>-1</sup>の測定で充分であるので、通常は FT-IR 分光計が分散型分光計に比較して S/N で最高約 20倍まで有利ということになる. ただし, 3,300 cm<sup>-1</sup> 以上の高波数域と 700 cm<sup>-1</sup> 以下の低波数域では FT-IR 分光計の有利さはほとんどない. この報告以後,分散型 分光計及び FT-IR 分光計共に新じい機種が出ているが, 性能的な違いはほぼ以上の結果に代表されると考えるこ とができるであろう.



図1 FT-IR 分光計と分散型分光計の RFM の比 較, R:分解能, RFM=(S/N)<sub>FT-IR</sub>/(S/N) <sub>分数型</sub>(文献7)

## 3. ATR 法のスペクトル測定原理

図2のように屈折率の異なる2つの透明な物質1及び 2[屈折率 $n_1$ 及び $n_2(n_1 > n_2)$ ]の界面に屈折率のより大き い物質側から光が入射するとき、入射角 $\theta$ が臨界角  $\theta_c$ [=sin<sup>-1</sup>( $n_2/n_1$ )]より大きければ光はこの界面で全反射 する<sup>8)</sup>. この際、界面の物質2側には界面からの距離と 共に指数関数的に減衰するエバネッセント波(Evanescent Wave)が生ずる<sup>9)</sup>. 図3にエバネッセント波の減衰 挙動を示す、物質2中における界面からの距離をzとす れば、エバネッセント波の振幅 E は

$$E = E_0 \exp\left(-z/d_p\right) \tag{1}$$

 $d_{p} = (\lambda/2\pi n_{1}) [\sin^{2}\theta - (n_{2}/n_{1})^{2}]^{-\frac{1}{2}}$ (2)

の式で表される. ここで,  $E_0$  は単位振幅の入射光に対 するエバネッセント波の界面における振幅であり,  $n_1$ ,  $n_2$ 及び $\theta$ の関数であって,  $d\mu$  はエバネッセント波が界 面での振幅に対して 1/e に滅衰する界面からの深さであ り,入り込み深さ(Penetration Depth)と呼ばれる.  $\lambda$ は 赤外光の真空中における波長である. 通常  $d_p$  はほぼ10 分の 1 波長程度である.

物質2が透明なとき、すなわち吸光係数k=0のとき には、図4に示すように $\theta_c$ 以上では全反射が起こるが、  $k \neq 0$ のときには物質2によるエバネッシェント波の吸 収のために、全反射からの減光(Attenuation)が起こ る<sup>10)</sup>. その減光の程度はkの値が大きい程増大する. ATR 法の名称は減光を受けた全反射光(Attenuated Total Reflection)を記録して物質2の吸収スペクトルを 測定することに由来する〔屈折率のより大きい物質側か らより小さい物質側に光が入射するときの光の反射現象



図2 ATR 法の測定原理



図3 エバネッセント波の減衰挙動

(45)



図4 反射率挙動の吸光係数R依存性 R,:垂直 偏光に対する反射率, R<sub>p</sub>:平行偏光に対す る反射率 (文献10)

を内部反射(Internal Reflection)と呼ぶが, ATR 法は内 部反射を利用した分光法であるため, ATR 法の代りに Internal Reflection Spectroscopy 又は IRS という名称も 用いられる).

ATR 法では物質1.が内部反射エレメント(Internal Reflection Element, IRE)と呼ばれる. IRE は屈折率が 大きく,赤外域に吸収のない材質でなければならない. これには KRS-5(屈折率2.4), ZnSe(2.4), Si(3.5), Ge(4.0)などが用いられる.物質2が測定対象試料に相 当する.

図2において、IREに試料の接触していない場合の 反射光の強度を $I_{ro}$ ,試料が接触している場合の反射光 の強度を $I_c$ とすると、反射率Rは

 $A = -\ln R$ 

$$\div a$$
 (4)

で表される. Harrick によれば透過スペクトルにおける 単位厚さ当たりの吸光係数をαとすると,αが小さく, 試料が十分厚ければ,

$$a = \frac{n_2}{n_1} \frac{\alpha}{\cos \theta} \int_0^\infty E^2 dz$$
 (5)

$$=\frac{n_2}{n_1}\frac{E_0^2\alpha}{\cos\theta}\frac{dp}{2}$$
(6)

で与えられる?).

透過スペクトルでは吸収バンドの単位厚さ当たりの吸 光度は試料に固有な値である.しかし、ATR スペクト ルでは式(6)から明らかなように、吸光度は $\alpha$ 以外に、  $n_1, n_2$ 及び $\theta$ に依存し、スペクトルの特徴が測定条件に よって微妙に変化する.

# 4. ATR 法で測定する表面層厚さ

いま, 界面からz=tまでの厚さの表面層のaへの寄与分a(t)とすると, これは

$$a(t) = \frac{n_2}{n_1} \frac{\alpha}{\cos \theta} \int_0^t E^2 dz$$
(7)

$$= \frac{n_2}{n_1} \frac{E_0^2 \alpha}{\cos \theta} \frac{d_p}{2} \left[ 1 - \exp\left(-\frac{2t}{dp}\right) \right] \tag{8}$$

である<sup>II)</sup>. したがって,  $d_{\mu}$ に比較して十分に厚い( $\infty$ ) 試料とt厚さの試料のATR スペクトルにおける対応す る吸収バンドの吸光度, それぞれ,  $A(\infty) \ge A(t) \ge 0$ 間 には

$$A(t) = A(\infty) [1 - \exp(-2t/d_p)]$$
(9)

の関係がある.式(9)は吸光係数αが小さいとの仮定の 下に得られた関係であり、実際の試料でどれほど成立す るものか明らかでなかった.太田らはポリスチレンを表 面層とし、ポリウレタンを下地層とする二重層試料につ いての ATR スペクトルの測定から、通常の強度の吸光 バンドについて式(9)の関係が充分に成立することを明 らかにした<sup>11)</sup>.

式(9)の関係は ATR 法で測定する表面層厚さを決定 するときに有効な、大変重要な関係式である.  $A(\infty)$ が 既知のとき、任意の厚さの表面層を持つ試料について得 た ATR スペクトルにおける吸光度 A(t)から、表面層厚 さ t は

636

(46)

第58巻 第10号(1985)

(10)

$$t = -\frac{d_p}{2} \ln \left[ 1 - \frac{A(t)}{A(\infty)} \right]$$

の関係から求められる11).

また,厚さιの表面層のA(∞)に対する寄与率は次式 から求められる<sup>11)</sup>.

$$c(t/d_p) = A(t)/A(\infty)$$

=1-exp $(-2t/d_p)$  (11) この関係は図 5 の曲線で表わされるが、 $t/d_p=1/2$ 、1.0、 2.0及び3.0に対して、それぞれ、 $C(t/d_p)=0.632$ 、0.864、 0.982及び0.998である. すなわち、 $t=2 d_p$ よりも厚い層 はATR スペクトルの吸光度にはほとんど寄与しない.

従来、ATR 法で測定する層面層の厚さには $d_p$ が用いられてきた.  $d_p$  厚さの表面層の全吸光度  $A(\infty)$ に対する 寄与は86%である. このうち、 $z=0\sim d_p/2$ の  $d_p/2$  厚さ の表面層が63%の寄与を持つのに対して、 $z=d_p/2\sim d_p$ の同じ $d_p/2$  厚さの層の寄与は23%であり、前者の約3 分の1である. すなわち、ATR スペクトルでは  $d_p/2$  厚 さの表面層についての情報が最も密に集積されている. このことから、筆者らはATR 法で測定する表面層厚さ として  $d_p/2$  を用いることを提案している<sup>11</sup>.

試料の屈折率( $n_2$ )を1.5とすると、いろいろな測定条件に対する  $d_p/2\lambda$  は表 1 のようになる。例えば、KRS-5 又は ZnSe の IRE の場合、 $\theta=45^\circ$ の測定では

 $d_p/2=0.10 \lambda$ であり, Geの IRE の場合,  $\theta=45^{\circ}$ の測定では  $d_s/2=0.033 \lambda$ 



図5 表面層厚さと吸光度への寄与率 (文献14)

#### 表1 種々の測定条件におけるd<sub>p</sub>/2λ値

IRE	<b>n</b> <sub>1</sub>	$\frac{\theta_{c}(\circ)}{(n_{2}=1.5)}$	30°	$/2\lambda(n_2=1)$ 45°	.5) 60°
KRS-5	2.4	38.7	_	0.10	0.055
ZnSe	2.4	38.7		0.10	0.055
Si	3.5	24.5	0.090	0.040	0.030
Ge	4.0	22.0	0.060	0.033	0.025

である.

吉

#### 5. 実効厚さ

透過法による測定では吸光度は試料厚さに比例する. ATR 法では吸光度は一般に試料厚さに比例しないが, 透過スペクトル法における試料厚さに対応するものとし て実効厚さ(Effective Thickness)が用いられる<sup>3)</sup>.

透過法では試料厚さをd,入射光及び透過光の強度 を,それぞれ、I<sub>0</sub>及びIとすると,

$I/I_0 = e^{-\alpha d}$	(12)
の関係がある. ここで, αd≪1とすると,	
$I/I_0 \doteqdot 1 - \alpha d$	(13)
であり、式(3)と式(13)との対比から	
$a = \alpha d$	(14)

となり、式(5)と式(14)から実効厚さんは

$$d_{z} = \frac{n_{2}}{n_{1}} \frac{1}{\cos \theta} \int_{0}^{\infty} E^{2} dz$$
$$= \frac{n_{2}}{n_{1}} \frac{E_{0}^{2}}{\cos \theta} \frac{d_{p}}{2}$$
(15)

と定義される. *d* を用いると ATR スペクトルにおける 吸光度は

$$a = d_{\epsilon} \alpha$$
 (16)

で表される. αは試料に固有であり, d,は ATR スペク トルの測定条件によって変化する.

反射面に対して垂直及び平行な電気ベクトルを持つ偏 光に対する実効厚さは、 $n_1$ =4.0(Ge)、 $n_2$ =1.5の場合、 図6の曲線で表される.これらの偏光に対する実効厚さ を $d_{el}$ 及び $d_{el1}$ で表すと、常に

 $d_{e11} > d_{e1}$  (17) である. すなわち, 偏光測定では平行偏光スペクトルに おける吸光度が垂直偏光スペクトルにおける吸光度より も常に大きい. 特に $\theta$ =45°のとき

d<sub>11</sub>=2 d<sub>1</sub> (18) であり,平行偏光スペクトルにおける吸光度が垂直偏光 スペクトルにおける吸光度のちょうど2倍となる<sup>11)</sup>.

図6の曲線によれば d<sub>a</sub> 又は d<sub>ai</sub> のいずれも臨界角に 近づくと値が急激に増大する.したがって、ATR スペ クトルにおける吸光強度を増大するには臨界角に近い入 射角で測定するとよい.しかし、臨界角に近い入射角で は n<sub>2</sub>の異常分散がピーク波数や吸収バンドの形状に微 妙に影響するため留意する必要がある.

#### 6. 測定可能な表面層厚さの限界

通常、表面分析を必要とする試料は表面層と下地層の

(47)

637



図6 d<sub>e</sub>/λの入射角依存性,⊥:垂直偏光, ||:平 行 偏光, n<sub>1</sub>=4.0(Ge), n<sub>2</sub>=1.5

表2 ポリスチレンの3つの吸収バンドに対する t<sub>L</sub>値

波 数 (cm <sup>-1</sup> )	ΔΑ	A(∞)	$\begin{pmatrix} d_{p} \\ (\mu m) \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} t_L \\ (A) \end{pmatrix}$
1452	0.0014	0.348	0.469	9.7.
1493	0.0013	0.360	0.456	8.0
1601	0.0017	0.118	0.425	31

スペクトルの間に(1)違いのないとき及び(2)違いのある ときに大別される.前者の場合には差スペクトル法を適 用できないため,測定表面層の厚さは,前述のように d<sub>p</sub>/2 となる.後者の場合には差スペクトル法を利用して表面 層のスペクトルを分離することができる.この場合 ATR法でどれ程薄い表面層を測定できるかについて述 べる.

測定可能な薄さの限界は ATR 測定における吸光度の 測定精度によって決定される.筆者らは分光計の持つ/ イズレベルを測定し、ノイズレベルと差スペクトルで検 出可能な最小シグナル値との関係を調べた<sup>12)</sup>.その結 果、シグナル値がノイズレベルの 2~4 倍であれば十分 検出可能であることを明らかにした<sup>12)</sup>.ここでその詳細 については省略するが、結果の一部のみについて述べる.

検出可能な最小吸光度(Detectable Least Signal Increment)を  $\Delta A$  とすると、最小の測定可能な表面層厚さ  $t_{L}$  は

 $t_1 = [\Delta A/A(\infty)](d_p/2)$  (19) で表される<sup>(2)</sup>. この式に基いてポリスチレンについて計 算すると表 2 のようになる.



図 7 ポリウレタンフィルムの FT-IR-ATR スペ クトル(Ge, 45°), (a)表面に 55Å 厚さのポリ スチレン層を持つ場合及び(b)持たない場合 (文献12)

ここでポリスチレンを表面層,ポリウレタンを下地層 とする2重層試料について差スペクトル法でポリスチレ ンのスペクトルを分離した例について述べる.図7は 55Å厚さのポリスチレンを表面層として持つ場合(a)と 持たない場合(b)のスペクトルである.1452,1493及び 1601 cm<sup>-1</sup>にポリスチレンの吸収があるが,図7のaと bのスペクトルではこの波数位置でまったく違いが認め られない.しかし,図7の差スペクトル(a-b)を取る と,図8bのように上記の3つの吸収は明瞭に分離され る.これは表2から予想される通りである.図8aは同 じ55Å厚さのポリスチレン薄膜単独のATR スペクトル である.

従来, ATR 法では 100Å よりも薄い表面層の測定は 困難と考えられてきたが,実際には差スペクトル法を利 用して 50Å 程度の厚さの表面層は比較的容易に測定さ れる. さらに,下地層の吸収が分離するスペクトルの S/N 比に及ぼす影響をも予測できることが明らかにさ れた<sup>12)</sup>.

## 7. ATR 法による表面分析

ATR 赤外法は化学処理表面,光照射に伴う表面層の

(48)





化学変化の追跡に用いられてきた、しかしながら、表面 層の厚さや組成などについて定量的な情報を得る目的に ATR 法を応用した例は極めて少ない、その理由は(1)光 学系の調整,(2) IRE と試料との接触の不充分さなどに より良質のスペクトルの測定が困難であったことによ る.また、ATR スペクトルの特徴が n<sub>1</sub>, n<sub>2</sub> 及び θ に微 妙に依存し、透過スペクトルの場合のようにスペクトル の解釈が必ずしも単純でないことも一因になっている. 以下には FT-IR-ATR 法を表面分析に有効に利用する ための測定上の留意点についてまず説明する.

表面層厚さについて確かな情報を得るためには測定上の誤差によって $d_p$ の受ける変動が可能な限り小さい条件で測定することが不可欠である. 図9に $n_1$ =2.4 及び4.0, $n_2$ =1.5 及び1.7に対する $d_p/\lambda$ の $\theta$ 依存性を示した.  $d_n$ が変動する原因には(1) $\theta$ の設定誤差,(2)赤外ビームが



図9 d<sub>p</sub>/λの入射角依存性,1:IRE,Ge; n<sub>2</sub>=1.5,1':IRE,Ge;n<sub>2</sub>=1.7,2:IRE, KRS-5(又はZnSe),n<sub>2</sub>=1.5,2';IRE, KRS-5(又はZnSe);n<sub>2</sub>=1.7,図中の横棒 は空気中のビーム分散角10°とした場合の IRE 中における分散角(文献14)

平行光でなく、分散角を持つこと、(3) $n_2$ の異常分散な どがある. これらの $d_p$ への影響は図9から判断される. 2の曲線で、 $\theta=45^\circ$ では $\theta$ の少しの変動が $d_p/\lambda$ に大き な誤差を持たらす. これに対して、1の曲線では、  $\theta=45^\circ$ において $\theta$ の変動に対する $d_p/\lambda$ の変化率は小さ く、 $\theta$ の誤差は $d_p/\lambda$ にほとんど誤差を生じさせない.

試料の屈折率 $n_2$ の異常分散の影響を $\Delta n_2$ =+0.2の場 合について1'及び2'の曲線で示した. $n_1$ =4.0の場合に は曲線1'のように $n_2$ のこの変動の影響は小さいが,  $n_1$ =2.4の場合には $\Delta n_2$ =+0.2の変動の影響は著しく,  $\theta$ =45°はこの場合の臨界角よりも小さくなる.この場 合, $n_2$ =1.5として求めた $d_p$ は信頼性が低いだけでな く,吸収ピークの波数シフトや吸収バンドの形状変化が 起こる可能性がある.

通常,高分子あるいは有機化合物の $n_2$ は1.5付近にあ り,異常分散に伴う $\Delta n_2 = \pm 0.2$ 程度の変動は必ずしも まれではない<sup>13)</sup>. ATR スペクトル法によって $d_i$ を基に した情報を得ようとするときには $n_i = 2.4$ (KRS-5 又は ZnSe), $\theta = 45^\circ$ の条件は適当ではない. ATR スペクト ルに透過スペクトルと異なる変化の現われた場合には, 条件 $(n_i, \theta)$ を変えて測定し,その変化が光学的原因に よるものではないことを確認することが重要である.

さらに, FT-IR-ATR 法を有効に利用するには差スペクトル法の応用が不可欠である.「化学的に有意な」差スペクトルを得るには再現性に優れた測定法を確立する

(49)

ことが極めて重要である. 筆者らは ATR 法に差スペク トル法を応用するに当たって上記の種々の因子を検討 し, 深さ分布を必要としないときには $n_1$ =4.0(Ge),  $\theta$ =45°の条件を選んだ<sup>14</sup>).

#### 7.1 表面層の定量分析

ATR 法はゴムの微細構造分析<sup>(5)</sup>やコポリマーの組成 分析<sup>(6)</sup>に応用されている.これらの例では表面分析では なく,透過法と同様に検量線を用い,バルクの分析に用 いられた.表面分析を必要とする試料では標準試料の調 製が困難であり,検量線を用いることができない.した がって,表面層を定量分析するには

(1) 試料に含まれる各成分に特有なバンド間の吸光度 比が得られること

(2)各成分の特有パンドを分離できること が必要である。

まず,(1)の吸光度比の決定法について述べよう、

式(16)によれば ATR スペクトルにおける吸光度は吸 光係数  $\alpha$  と実効厚さ d, との積である。IRE と試料との 接触界面での赤外光の反射回数を N, IRE と試料との 密着の完全度をgとすると、実質実効厚さ D, は

D,=Ngd, (20) と定義される.この場合,ATR スペクトルにおける吸 光度 A は

 $A = \alpha D_{c}$ 

(21)

で表されている. そこで, 試料に含まれる各単独成分間 で D, が等しくなるように ATR スペクトルを測定すれ ば, 各成分に特有なバンド間の相対吸光度を得る. D, を等しくするには, IRE と試料との間の接触を完全 (g=1)とし, 各試料の大きさを一定にし, θの設定誤差 及び n2の異常分散及び変動が d, に影響しない条件で測 定する必要がある. (2)の特有バンドの分離は分析対象試 料のスペクトルから単独成分のスペクトルを差し引くこ とによって行われる. 次に上述の方法の応用例について 述べる.

Cardiothane 51 は少ない市販の抗血栓性材料の1つで ある.これはポリウレタンを主成分とし、約10%のシリ コーンを含むが、血液と接触する表面のシリコーン含有 量が抗血栓性の発現と密接に関係するとされている<sup>17)</sup>. このため、ATR 法<sup>18)</sup>、ESCA<sup>19)20)</sup>、SIMS<sup>20)</sup>、オージェ 電子分光<sup>21)</sup>などによる分析が報告されている.筆者らは 上述の方法で表面層の定量分析を行った<sup>14)22)</sup>.

図10は Cardiothane 51 試料のキャストフィルムの空 気側及びガラス側表面の ATR スペクトルである.分析 にはポリウレタンの 1532 cm<sup>-1</sup> バンドとシリコーンの



図10 Cardiothane 51キャストフィルムの FT-IR-ATR スペクトル(a)空気側及び(b)ガラス側 表面(文献14)

801 cm<sup>-1</sup> バンドが用いられた.ポリウレタン及びシリ コーン単独試料について  $D_e$ を同じになるように測定し たスペクトルから  $r_0=A_{801}/A_{1532}=6.01$ を得た.

一方, Cardiothane 51 試料のスペクトル中の801 cm<sup>-1</sup>バンドはポリウレタン成分単独試料のスペクトルと の間で差を取ることによって図11のように分離できた. 分析対象試料のスペクトルにおける吸光度比( $A_{801}/A_{1532}$ ) をrとするシリコーン含有量  $x_i$ は

Cardiothane 51 の 6 個のバルーンポンプについての表面分析の結果,血液と接触する側の表面でのシリコーン 含有量は0.7から5.3%と著しい変動があるうえに,両表面(空気側と基質側)の間で相対含有量が変動するという結果を得た<sup>22)</sup>.

次にアルカリ処理したポリアクリロニトリル(PAN) フィルム表面を定量分析した例について述べよう<sup>23)</sup>.

PAN の CN はアルカリ処理によって

--CN --> --CONH<sub>2</sub> 及び --COONa に加水分解される.図12がこれに伴う ATR スペクトル の変化である.2243 cm<sup>-1</sup> バンドが CN,1671 cm<sub>-1</sub> バ ンドが CONH<sub>2</sub> 及び 1568 cm<sup>-1</sup> バンドが COONa に由 来する.そこで,

 $+ CH_2CH +_n, + CH_2CH +_n$ I CN CONH<sub>2</sub> 及び

640

(50)

吉







図12 PAN フィルムの(b)アルカリ処理前及び(a) アルカリ処理後の FT-IR-ATR スペクトル 及びこれらの差スペクトル(a-b)(文献23)

+CH<sub>2</sub>CH + "

COONa

の各ホモポリマーについてD.が等しくなるように ATR スペクトルを測定し、これらにおける各特有バン ドの吸光度をA2245、A1671及びA1568とする.次に、分析 対象の各アルカリ処理試料についてもD.が等しくなる ように測定し、このスペクトルにおける上記の各バンド の吸光度を $a_{2243}$ , $a_{1671}$ 及び $a_{1568}$ とする. CNの含有量は  $x_{CN} = a_{2243}/A_{2243}$ ,CONH<sub>2</sub>及びCOONaの生成量は、そ れぞれ、 $x_{CONH_2} = a_{1671}/A_{1671}$ 及び $x_{COON_a} = a_{1568}/A_{1568}$ によ って各独立に求められる<sup>23)</sup>.

アルカリ処理によって PAN フィルム表面が粗くなり, 試料と IRE との密着の低下が起こる場合があった. 内部標準バンドを用いることによって密着の不完全さを 補正する方法が取られた<sup>23)</sup>.この補正によって

x<sub>CN</sub>+x<sub>CONH2</sub>+x<sub>COONa</sub>=1.0 の満足される結果を得ている.

7.2 その他の表面分析への応用

上述の ATR 法の表面層の定量分析への応用は現在研 究が進められているところである。その他のいろいろな 問題に ATR 法が用いられているが、以下にはその概要 を述べるにとどめる。

ゴムのオゾンによる表面酸化が研究されている.種々 のゴムの中で天然ゴムがオゾン酸化を受けやすい.これ は天然ゴム中に含まれるアセトン可溶分によることが明 らかにされている<sup>24)</sup>.架橋ゴム,カーボンブラック充塡 ゴムのオゾン酸化も研究されている<sup>25)</sup>.また,オゾン酸 化防止剤 N,N-dioctyl-p-phenylenediamineの効果につ いての研究によれば,この防止剤はゴム表面にオゾンに 対する保護膜を形成し,"Scavenger"的な働きをするこ とが明らかにされた<sup>26)</sup>.

ポリプロピレンフィルムは光照射によって表面酸化を 受ける.酸化によって生ずる ROOH 及び C=O は、そ れぞれ、3,400及び1,715 cm<sup>-1</sup> に吸収を持つ.Carlsson らは ATR スペクトル測定からこれらの酸化生成物の深 さ方向分布を求めた<sup>27)28)</sup>.

図13はn<sub>1</sub>及びθの異なる測定条件におけるd,を横軸



図13 光照射ポリプロピレンフィルムにおける 1,715 cm バンドの吸光度の dp 依存性, 照射 時間:0,40時間:●,70時間(文献28)

(51)



図14 光酸化によって生じた ROOH 及び C=Oの 深さ方向分布,照射時間:O,40時間:●, 70時間(文献28)

に取り、1715 cm<sup>-1</sup>バンドの吸収強度が  $d_{y}$ と共に変化す る様子を示したものである.酸化生成物が表面に局在し ていることがよくわかる.しかし、ATR 法での測定値 は式(5)から明らかなように表面からの積分であり、存 在量の分布そのものを示すものではない.そこで、酸化 生成物の深さ方向分布に指数関数  $c(z) = A \exp(-bz)$ を仮 定し、 $d_{y}$ の異なる条件における測定値から係数 A、bを 決定し、ROOH 及び C=0の深さ分布曲線が求められ た.照射時間の異なる2つの場合について得られたのが 図14である.

また、ポリプロピレンの場合、光照射によって表面酸 化が進むとともに表面層におけるヘリックス構造の存在 量が増加するという興味深い結果が報告されている<sup>29</sup>.

8. 結 び

以上,筆者らの研究を中心に FT-IR-ATR 法の原理 と表面分析への応用について紹介した.

表面測定法の中には新しい原理による方法が次々に開発されている. ATR 法は表面分析法として取り扱われないことが多い. これはエバネッセント波の試料への浸入深さが場合によっては数ミクロンにも達し, ごく薄い表面層の情報だけを取り出すことが技術的に困難なことに原因する. しかし, 差スペクトル法を巧妙に使うことによって, 10Å 程度の表面層についても FT-IR-ATR法で測定できることが明らかになってきた.

FT-IR-ATR 法は利用の仕方によっては他の表面測定 法と同等又はそれ以上の表面分析能力を潜めている。有 機化合物や高分子材料については豊富な赤外スペクトル の集積がある。また、赤外スペクトルは化学構造だけで なく、立体構造、水素結合、結晶性、分子配向などについて豊かな情報を提供する。これらの特長を生かし、また技術的には差スペクトル法を有効に活用することによって、新しい表面分析法としての道が拓かれるものと期待される。

## 文 献

- 1) Harrick, N. J.: J. Phys, Chem., 64, 1110(1960).
- 2) Fahrenfort, J.: Spectrochim. Acta, 17, 698(1961).
- Harrick, N. J.: "Internal Reflection Spectroscopy" John Wiley & Sons, Inc., N. Y.(1967).
- Iwamoto, R., Miya, M., Ohta, K., Mima, S.: J. Chem. Phys., 74, 4780(1981).
- Griffiths, P. R.: "Chemical Infrared Fourier Transform Spacetroscopy" John Wiley & Sons, Inc., N. Y.(1975).
- Kenig, J. L.: Adv. Polym Sci., 54, 87(1983): 田中誠
   之,寺前紀夫:化学の領域増刊, 139号, p. 1(1983).
- 7) Chenery, D. H., Sheppard, N.: Appl. Spectrosc. 32, 79(1978).
- Born, M., Wolf, E.: "Principle of Optics" Pergamon Press, Oxford(1959), p. 47.
- 9) Harrick, N. J., J Opt. Soc. Am., 55, 851(1965).
- Chandler, I. R., Tomaselli, V. P., Moller, K. D.: Appl. Optics, 22, 4099(1983).
- Ohta, K., Iwamoto, R.: Appl. Spectrosc, 39, 418(1985).
- 12) Ohta, K., Iwamoto, R.: Anal. Chem. "Lower Limit of the Thickness of the Measurable Surface Layer by Fourier Transform Infrared Attenuated Total Rrflection Spectroscopy" 印刷中.
- 13) Goplen, T. G., Cameron, D. G., Jones, R. N.: Appl, Spectrosc., 34, 657(1980).
- 14) Iwamoto, R., Ohta, K.: Appl, Spectrosc, 38, 359(1984).
- 15) 林順之助,吉川淳二,山下晋三:高分子化学,23, 527(1966),23,531(1966).
- Mirabella, F. M. Jr.: J. Polymer Sci. Polymer Phys.
   Ed., 20, 2309(1982); French, A. R., Benham, J. V.,
   Pullukat, T. J.: Appl.Spectrosc., 28, 477(1974).
- Nyilas, E., Ward, R. S. Jr.: J. Biomed. Mater, Res. Symp., No. 8, 69(1977); Kellner, R., Unger, F.: Z. Anal. Chem., 283, 349(1977).
- 18) Paik Sung, C. S., Hu, C. B., Merrill, E. W., Salzman, E. W.: J. Biomed. Mater. Res., 12, 791(1978).
- Paik Sung, C. S., Hu, C. B.: J. Biomed. Mater. Res., 13, 161(1979).
- 20) Graham, S. W., Hercules, D. M.: J. Biomed. Mater. Res., 15, 349(1981).
- 21) Paik Sung, C.S., Hu, C. B.: J. Biomed. Mater. Res.

岩

13, 45(1979).

- 22) Iwamoto, R., Ohta, K., Matsuda, T., Imachi, K.: J. Biomed. Mater. Res. "Quantitative Surface Analysis of Cardiothane 51 by FT-IR-ATR Spectrosc." 1200(1985).
- 23) 太田浩二, 岩本令吉:日化誌, 1200(1985).
- 24) Andries, J. C., Diem. H. E.: J. Polymer Sci, Polymer Lett. Ed. 12, 281(1974).
- 25) Andries, J. C., Ross, D. B., Diem, H. E.,: Rubber Chem. Technol., 48, 41(1975).
- 26) Andries, J. C., Rhee, C. K., Smith, R. W., Ross, D.
  B., Diem, H. E.; Rubber Chem. Technol., 52, 823(1979).
- 27) Carlsson, D. J., Wiles, D. M.: Can, J. Chem, 48, 2397(1970).
- 28) Carlsson, D. J., Wiles, D. M.: Macramolecules, 4, 174(1971).
- 29) Blais, P., Carlsson, D. J., Wiles, D. M.: J. Polymer Sci., A-1, 10, 1077(1972).

H1900585

# Du Pont 社,酸素しゃ断用の合成樹脂のフィルム 工場を計画

Du pont to make oxygen-barrier resin

Du Pont 社(米)は、エチレン-ビニルアルコール製の 酸素しゃ断用フィルムを年産5,000万 lb の規模で生産す る工場を米、テキサス州に計画中である.同社は、エチ レン-ビニルアルコールの両面を他のプラスチックでは さんで作った積層フィルムが、スープやプディングなど の低酸性で酸素に敏感な食品の包装に適することを発見 し、その需要が1993年には150億ユニットに達すること を予測している.同社のポリマ製品担当副社長 N. Pappas は、現在、エチレン-ビニルアルコールが日本から しか入手できないと述べている.

同社の包装製品担当役員 W. A. Jenkins は,次に述べる理由から,この積層フィルムが占める包装用フィルム

市場への比率が,現在の190億ドル市場の17%から, 2000年には440億ドルの食品包装市場の50%に成長する ことを予測している.その理由の第一は,米国の婦人の 就業率が,現在は60%であるが,'90年には70%に増加 すること,第二は,米国の家庭の電子レンジ保有率が, 現在は35%であるが,'90年には50%まで増加すること である,という.

彼は、栄養分があり、新鮮で、高品質の食品を能率よ く調理することへの要求が上述の二つの理由によって増 加し、同社が開発した積層フィルムを使用することによ って、この要求が満たされると考えている.このフィル ムで包装された食品は、常温で保存、販売され、包装の まま電子レンジで調理することができる.

B249A Chem Eng News 63 [15] 8 (Apr. 15, '85) [日本科学技術情報センター発行 [海外技術ハイライト] から転 載, 許可第文6019号]

(53)